



Краснознаменский завод
полупроводниковых приборов
«Арсенал»

143090, Краснознаменск,
Московской обл., а/я 226.
Тел. (факс): (495) 648-78-67
590-97-06

Транзисторы

2ТЗ117А/ПК
2ТЗ117А1/ПК
2ТЗ117А2/ПК
2ТЗ117А3/ПК

АЕЯР.432140.247ТУ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные высокочастотные п-р-п транзисторы 2ТЗ117А/ПК, 2ТЗ117А1/ПК, 2ТЗ117А2/ПК, 2ТЗ117А3/ПК выполнены в металлостеклянном корпусе КТ-1 и предназначены для работы в оперативных запоминающих устройствах и другой аппаратуре специального назначения.

Типонаименование	Обозначение	l, мм	Покрывание Б
2ТЗ117А /ПК	ПКНС.432140.001	13,5±1	Золото 2,5 мкм
2ТЗ117А1/ПК	ПКНС.432140.001-01	23±1	Золото 2,5 мкм
2ТЗ117А2/ПК	ПКНС.432140.001-02	13,5±1	ПОС-61
2ТЗ117А3/ПК	ПКНС.432140.001-03	23±1	ПОС-61

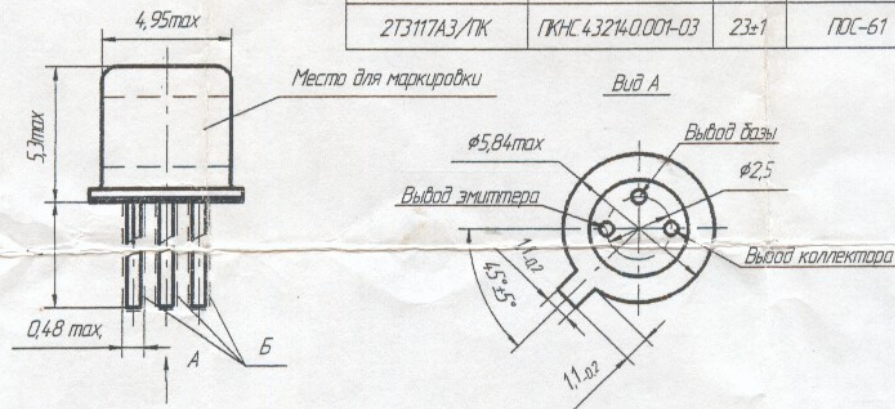


Рис. 1. Габаритные размеры транзистора.
Масса – не более 0,5г

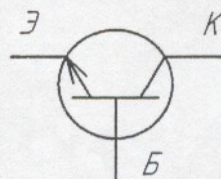


Рис. 2. Схема соединения электродов с выводами.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Основные электрические параметры.

Наименование параметра единица измерения (режим измерения),	Буквенное обозначение	Значение параметра	
		не менее	не более
1	2	3	4
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КБ} = 5В$, $I_Э = 200мА$, $t_u \leq 30мкс$, $Q \geq 50$)	$h_{21Э}$	40	200
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ} = 60В$)	$I_{КБО}$		5

1	2	3	4
Обратный ток эмиттера, мкА, ($U_{ЭБ}=4В$)	$I_{ЭБО}$		5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_K = 400мА, I_E = 50мА$)	$U_{КЭ\text{ нас}}$		0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_K = 400мА, I_E = 50мА$)	$U_{БЭ\text{ нас}}$		1,2
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КЭ} = 10В, I_K = 30мА, f = 10^8 Гц$)	$/ h_{21Э} /$	3,0	
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ} = 10В, I_Э = 0, f = 10^7 Гц$)	C_K		10
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ} = 0, f = 10^7 Гц$)	$C_Э$		80
Время рассасывания, нс ($I_K = 400мА, I_{Б1} = I_{Б2} = 50мА, t_n \leq 30мкс, Q \geq 50$)	$t_{рас}$		60

2. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов, г	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода, г/мм	Толщина покрытия, мкм
Золото	0,54		
Серебро			

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ.

Транзисторы 2Т3117А/ЛК, 2Т3117А1/ЛК, 2Т3117А2/ЛК, 2Т3117А3/ЛК соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.247ТУ

Приняты по извещению № 37/6 от 18.04 2007 г.

ОТК-375П
место для штампа ОТК

место для штампа представителя заказчика

14

Место для штампа «Перепроверка произведена»

дата

Приняты по извещению №

место для штампа ОТК

место для штампа представителя заказчика